

講演分科日程表（分科別） I

東京工業大学 大岡山キャンパス

大分類分科名 中分類分科名	3月19日(土)		3月20日(日)		3月21日(月)		3月22日(火)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
第16回応用物理学会業績賞受賞記念講演								
業績賞受賞記念講演			W541 ※ 10:00 ~ 10:45					
			KD ※ 10:45 ~ 11:30					
特別シンポジウム								
科学と産業の凋落と再興：応用物理と未来社会		KD 13:00 ~ 17:15						
産学協働シンポジウム・未来創生に向けて		S222 13:30 ~ 17:30						
応用物理分野で活躍する女性達 ー第4回 ブラズマと応用技術編ー					H101 13:00 ~ 17:50			
「Internet of Things を俯瞰する」- 応用物理から実装技術、アプリ、ビッグデータまで -					W9 13:00 ~ 18:30			
『フォノンエンジニアリングの広がり』～ナノスケール熱制御がもたらす、新しい熱伝導・断熱、蓄熱、変換技術の基礎と応用							KD 09:00 ~ 11:55	KD 12:45 ~ 15:00
分科企画シンポジウム								
S.1 エネルギーマネジメント：小規模システムの事例に学ぶ再生可能エネルギーの導入ポテンシャル		W641 13:30 ~ 17:00						
S.2 偏光計測制御の新展開		S621 13:30 ~ 17:15						
S.3 銅酸化物超伝導体発見 30 周年記念シンポジウム		H101 13:15 ~ 17:30						
S.4 日韓の有機エレクトロニクス研究：現状と次の飛躍に向けて		W521 13:45 ~ 18:00						
S.5 化合物薄膜太陽電池の高効率化技術の現在と未来		W541 13:15 ~ 18:45						
S.6 発光イメージングが切り拓く半導体結晶・デバイス評価の明るい未来		S011 13:30 ~ 17:45						
S.24 IoT アプリケーションと、それを支えるキーテクノロジー		W631 13:30 ~ 17:45						
S.8 日韓ジョイントシンポ：機能性2次元材料の現状と新展開	S221 09:45 ~ 12:00	S221 13:45 ~ 17:30						
S.9 科学教育コンテストを活用した次世代人材育成			W621 09:00 ~ 11:45					
S.10 医学分野における RI 利用の現状と展望				W9 13:30 ~ 16:45				
S.11 液中レーザープロセス技術の展開				W321 13:15 ~ 18:45				
S.13 真空・減圧プロセスにおける気体の流れの解析				W621 14:00 ~ 17:30				
S.14 機能性酸化物探索の新展開 ～ more oxide, beyond oxide ～				H111 13:15 ~ 17:30				
S.15 誘電体・強誘電体材料評価・解析技術の最先端				W641 13:45 ~ 18:15				
S.16 宇宙科学・工学とプラズマプロセス				KD 13:45 ~ 17:45				
S.17 様々なスピン計測技術を用いたスピントロニクス材料開発の最前線				W241 13:45 ~ 17:00				
S.18 計算材料科学の新潮流 - 有機分子・バイオエレクトロニクスを中心に -				W631 13:45 ~ 17:30				
S.7 理系学生のキャリア設計指針 ～これからの第一歩を決めるために～				W611 13:45 ~ 16:30				
S.12 社会実装を見据えたテラヘルツ新技術の展開					H135 13:30 ~ 18:00			
S.19 有機薄膜太陽電池の現状と今後の展望					W531 13:30 ~ 18:00			
S.20 次世代高効率・低コスト結晶シリコン太陽電池					KD 13:00 ~ 17:15			
S.21 金属酸化物薄膜の成膜装置					S222 13:30 ~ 18:15			
S.22 「cavity-QED, circuit-QED の進展」～様々な系で何をどこまでできるようになったのか？～						H101 09:00 ~ 13:00		
公募シンポジウム								
S.23 テラヘルツ・赤外線領域強電磁場による極限非線形現象の光科学と応用展望		H135 13:00 ~ 16:00						

会場名のアルファベットは建物名を表します。 <建物略称>

KD：70周年記念講堂 S3：南3号館 W5：西5号館 P：屋内運動場
 H1：本館 S4：南4号館 W6：西6号館
 SO：南講義棟 S6：南6号館 W8：西8号館
 S2：南2号館 W2・W3：西2・3号館 W9：デジタル多目的ホール

分科内招待講演あり

Invited lecture of overseas researcher あり

※ 応用物理学会業績賞（研究業績）受賞記念講演あり

※※ 女性研究者研究業績・人材育成賞（小館香椎子賞）受賞記念講演あり

* 光・量子エレクトロニクス業績賞（宅間宏賞）受賞記念講演あり

** 化合物半導体エレクトロニクス業績賞（赤崎勇賞）受賞記念講演あり

講演分科日程表について

(例)

	3月19日(土)		3月20日(日)		3月21日(月)		3月22日(火)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
P1	09:30 ~ 11:30		S322 10:15 ~ 12:15		W810 10:30 ~ 12:30	W810 13:45 ~ 15:45	W833 09:00 ~ 12:15	W833 13:15 ~ 15:00
	ポスターセッションのみ			場所の記号 (S322 会場)		講演時間		

講演分科日程表 (分科別) III

東京工業大学 大岡山キャンパス

大分類分科名 中分類分科名	3月19日(土)		3月20日(日)		3月21日(月)		3月22日(火)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
8 プラズマエレクトロニクス								
8.11 業績賞受賞記念講演			KD ※ 10:45 ~ 11:30					
8.10 プラズマエレクトロニクス賞授賞式				KD 13:30 ~ 13:45				
8.9 プラズマエレクトロニクス分科内招待講演		W241 # 13:45 ~ 14:15						
8.1 プラズマ生成・制御		P5 16:00 ~ 18:00			W611 09:00 ~ 12:00			
8.2 プラズマ診断・計測			KD 09:15 ~ 10:30			P4 13:30 ~ 15:30		
8.3 プラズマ成膜・表面処理		P6 16:00 ~ 18:00					W611 09:00 ~ 12:45	
8.4 プラズマエッチング		W621 14:30 ~ 17:45				P5 13:30 ~ 15:30		
8.5 プラズマナノテクノロジー						P6 13:30 ~ 15:30	W621 09:00 ~ 12:00	
8.6 プラズマライフサイエンス		P7 16:00 ~ 18:00			W621 09:00 ~ 12:15	W621 15:30 ~ 18:00		
8.7 プラズマ現象・新応用・融合分野		W611 14:30 ~ 18:00				P7 13:30 ~ 15:30		
8.8 Plasma Electronics English Session		P8 16:00 ~ 18:00				W611 15:30 ~ 17:15		
9 応用物性 ※コードシェアセッションあり 9.4 と 16.2 (表の末尾, コードシェアセッションを参照)								
9.1 誘電材料・誘電体		W833 13:45 ~ 15:00 P9 16:00 ~ 18:00	W833 09:30 ~ 12:00					
9.2 ナノワイヤ・ナノ粒子	W834 09:00 ~ 12:00	W834 13:30 ~ 18:00		P7 13:30 ~ 15:30				
9.3 ナノエレクトロニクス				P8 13:30 ~ 15:30	S323 09:15 ~ 12:15	S323 16:00 ~ 17:45		
9.4 熱電変換					W323 09:30 ~ 12:15	W323 13:45 ~ 16:45		
CS.5 9.4 熱電変換, 16.2 エナジーハーベスティングのコードシェアセッション		P13 16:00 ~ 18:00		W323 13:45 ~ 17:45				
9.5 新機能材料・新物性		P10 16:00 ~ 18:00		S323 13:45 ~ 17:00				
10 スピントロニクス・マグネティクス ※コードシェアセッションあり 10.1 と 10.2 と 10.3 (表の末尾, コードシェアセッションを参照)								
10.1 新物質創成 (酸化物・ホイスラー・金属磁性体等)					W241 09:00 ~ 12:00			
10.2 スピントルク・スピン流・回路・測定技術		P1 13:30 ~ 15:30				W241 13:15 ~ 19:00		
10.3 GMR・TMR・磁気記録技術			W241 09:00 ~ 12:15					
CS.6 10.1, 10.2, 10.3 のコードシェアセッション「新規スピン操作方法および関連現象」							W241 09:00 ~ 12:00	W241 13:15 ~ 14:15
10.4 半導体・有機・光・量子スピントロニクス		P1 13:30 ~ 15:30 W241 16:00 ~ 19:00						
10.5 磁場応用		P1 13:30 ~ 15:30						
11 超伝導								
11.1 基礎物性	W833 10:00 ~ 12:00			W833 13:15 ~ 18:15				
11.2 薄膜、厚膜、テープ作製プロセスおよび結晶成長					W834 09:00 ~ 10:15			
11.3 臨界電流、超伝導パワー応用			P3 09:30 ~ 11:30	W810 ※※ 13:45 ~ 16:45				
11.4 アナログ応用および関連技術					W833 09:00 ~ 12:15	W833 13:45 ~ 17:15		
11.5 接合、回路作製プロセスおよびデジタル応用				W834 13:45 ~ 17:00				
12 有機分子・バイオエレクトロニクス ※コードシェアセッションあり 3.7 と 12.6 と 12.7, 6.6 と 12.2 (表の末尾, コードシェアセッションを参照)								
12.1 作製・構造制御	P2 09:30 ~ 11:30	W242 13:45 ~ 15:30	W242 09:00 ~ 11:45	W242 13:45 ~ 18:00				
12.2 評価・基礎物性		P11 16:00 ~ 18:00			W631 09:00 ~ 12:00	W631 13:30 ~ 17:15	W631 09:00 ~ 12:15	W631 13:15 ~ 14:45
CS.4 6.6 プロープ顕微鏡, 12.2 評価・基礎物性のコードシェアセッション			W631 09:00 ~ 12:30					
12.3 機能材料・萌芽的デバイス	P3 09:30 ~ 11:30		W351 09:00 ~ 12:15	W351 # 13:45 ~ 18:00	W351 09:30 ~ 12:15	W351 13:45 ~ 18:00	W351 # 09:00 ~ 12:00	
12.4 有機 EL・トランジスタ	P4 09:30 ~ 11:30			W521 13:45 ~ 18:15	W521 09:30 ~ 12:15	W521 13:45 ~ 18:45	W521 09:00 ~ 12:15	W521 13:15 ~ 14:45
12.5 有機太陽電池	P5 09:30 ~ 11:30	W531 13:00 ~ 18:15	W531 09:00 ~ 11:45	W531 13:00 ~ 18:30	W531 09:00 ~ 12:00		W531 09:00 ~ 12:00	W531 13:00 ~ 14:45
12.6 ナノバイオテクノロジー	W323 09:00 ~ 12:15	W323 13:45 ~ 18:00	W323 09:00 ~ 12:15	P11 16:00 ~ 18:00				
12.7 医用工学・バイオチップ	W331 09:00 ~ 12:15	W331 13:45 ~ 18:00	W331 09:00 ~ 12:15	W331 13:45 ~ 15:45	W331 09:00 ~ 12:15			
CS.2 3.7, 12.6, 12.7 のコードシェアセッション「レーザー・ナノ・バイオ・プロセスとセンシングの融合に向けて」				P12 16:00 ~ 18:00			W331 13:45 ~ 19:00	

講演分科日程表（分科別）Ⅳ

東京工業大学 大岡山キャンパス

大分類分科名 中分類分科名	3月19日(土)		3月20日(日)		3月21日(月)		3月22日(火)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
13 半導体	※コードシェアセッションあり		3.11 と 13.7 (表の末尾, コードシェアセッションを参照)					
13.1 Si 系基礎物性・表面界面・シミュレーション	S223 09:00 ~ 12:30	P2 13:30 ~ 15:30						
		S223 15:30 ~ 18:00						
13.2 探索的材料物性・基礎物性				P13 16:00 ~ 18:00	S223 09:00 ~ 12:30	S223 13:30 ~ 18:00		
13.3 絶縁膜技術		P3 13:30 ~ 15:30	S221 09:00 ~ 12:15	S221 13:45 ~ 18:15				
13.4 Si 系プロセス・Si 系薄膜・配線・MEMS・集積化技術	S423 09:00 ~ 12:30	S423 13:45 ~ 18:15	S423 09:00 ~ 12:15	S423 13:45 ~ 18:45		P17 16:00 ~ 18:00		
13.5 デバイス/集積化技術		P4 13:30 ~ 15:30	S422 09:00 ~ 12:15	S422 13:45 ~ 18:30	S422 09:00 ~ 12:15			
13.6 Semiconductor English Session	S224 09:00 ~ 11:45							
13.7 ナノ構造・量子現象			S223 09:00 ~ 10:45	S223 13:45 ~ 15:45				
CS.3 3.11 フォトニック構造・現象, 13.7 ナノ構造・量子現象のコードシェアセッション						S621 13:45 ~ 19:00		
13.8 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術				P9 13:30 ~ 15:30	W541 09:00 ~ 12:15	W541 13:45 ~ 17:00	W541 09:00 ~ 11:45	W541 13:00 ~ 15:00
13.9 光物性・発光デバイス				P10 13:30 ~ 15:30	S423 09:30 ~ 12:00	S423 13:45 ~ 18:45	S423 09:00 ~ 12:15	S423 13:15 ~ 14:30
				S223 16:15 ~ 18:30				
13.10 化合物太陽電池			S011 10:00 ~ 12:00	S011 13:30 ~ 15:30	S221 09:30 ~ 12:15	S221 ※※ 13:45 ~ 17:45		
				P14 16:00 ~ 18:00				
15 結晶工学								
15.1 バルク結晶成長	H112 09:45 ~ 11:45	H112 13:15 ~ 17:15		P15 16:00 ~ 18:00				
15.2 II-VI 族結晶および多元系結晶					H113 09:00 ~ 10:15	P8 13:30 ~ 15:30	H116 09:00 ~ 10:30	H116 13:00 ~ 14:30
15.3 III-V 族エピタキシャル結晶				P16 16:00 ~ 18:00	H112 09:30 ~ 12:00	H112 13:15 ~ 16:45		
15.4 III-V 族窒化物結晶	H121 ※※ 08:45 ~ 11:45	H121 ** 13:15 ~ 18:00	H121 08:45 ~ 11:45	H121 13:15 ~ 19:45	H121 08:45 ~ 11:45	H121 13:15 ~ 18:00	H121 08:45 ~ 11:45	H121 13:15 ~ 15:00
							P6 09:30 ~ 11:30	
15.5 IV 族結晶, IV-IV 族混晶			H112 09:00 ~ 11:30	H112 13:15 ~ 16:30		P9 13:30 ~ 15:30		
15.6 IV 族系化合物 (SiC)			H101 09:00 ~ 11:45	H101 13:15 ~ 19:00	H101 09:00 ~ 12:00	P10 13:30 ~ 15:30		
15.7 エピタキシーの基礎					H112 09:00 ~ 09:30			
15.8 結晶評価, 不純物・結晶欠陥			H113 09:30 ~ 12:45	H113 14:15 ~ 17:45		P11 13:30 ~ 15:30		
16 非晶質・微結晶	※コードシェアセッションあり 9.4 と 16.2 (表の末尾, コードシェアセッションを参照)							
16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス					P8 09:30 ~ 11:30		W331 09:00 ~ 12:15	
16.2 エナジーハーベスティング								
CS.5 9.4 熱電変換, 16.2 エナジーハーベスティングのコードシェアセッション		P13 16:00 ~ 18:00		W323 13:45 ~ 17:45				
16.3 シリコン系太陽電池	W321 09:00 ~ 12:15		W611 09:00 ~ 12:15	S611 13:30 ~ 18:00	P8 09:30 ~ 11:30		W321 09:00 ~ 13:15	
17 ナノカーボン								
17.1 カーボンナノチューブ, 他のナノカーボン材料					S421 09:15 ~ 12:15	S421 13:45 ~ 19:00		
17.2 グラフェン			P4 09:30 ~ 11:30	S011 16:00 ~ 19:00	S011 09:00 ~ 12:15	S011 13:45 ~ 19:00	S011 09:00 ~ 13:15	
17.3 層状物質				S421 13:45 ~ 16:45			S421 09:00 ~ 12:00	
21 合同セッションK								
21.1 合同セッションK ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス		P12 16:00 ~ 18:00	S222 09:00 ~ 12:00	S222 13:00 ~ 17:30	S222 09:00 ~ 12:15		S222 09:30 ~ 11:30	S222 12:30 ~ 14:45
TU チュートリアル								
TU.1 はじめての光学 — 光の基礎からプラズモニクスまで —	W541 09:00 ~ 12:10							
TU.2 大気圧プラズマの基礎と農業への応用 — 超格安電源づくりから農作物生産や鮮度保持への活用まで —	W621 09:00 ~ 12:10							
TU.3 スピントロニクス入門	W641 09:00 ~ 12:10							
TU.4 半導体光デバイスの基礎と今後 — 青色 LED から深紫外 LED, LD, QCL へ —	W631 09:00 ~ 12:10							
TU.5 「半導体デバイス: 物理の基礎からデバイスの動作原理・回路への展開まで」 — もう一度, 学部基礎から復習してみよう —							W9 09:00 ~ 12:10	
TU.6 結晶成長を理解する							W641 09:00 ~ 12:10	
CS コードシェアセッション								
CS.1 3.5 レーザー装置・材料と 3.14 光制御デバイス・光ファイバーのコードシェアセッション					S611 09:00 ~ 11:30			
CS.2 3.7, 12.6, 12.7 のコードシェアセッション「レーザー・ナノ・バイオプロセスとセンシングの融合に向けて」						W331 13:45 ~ 19:00		
CS.3 3.11 フォトニック構造・現象, 13.7 ナノ構造・量子現象のコードシェアセッション						S621 13:45 ~ 19:00		
CS.4 6.6 プロローブ顕微鏡, 12.2 評価・基礎物性のコードシェアセッション			W631 09:00 ~ 12:30					
CS.5 9.4 熱電変換, 16.2 エナジーハーベスティングのコードシェアセッション		P13 16:00 ~ 18:00		W323 13:45 ~ 17:45				
CS.6 10.1, 10.2, 10.3 のコードシェアセッション「新規スピン操作手法および関連現象」							W241 09:00 ~ 12:00	W241 13:15 ~ 14:15

日程表 (会場別) 1

東京工業大学 大岡山キャンパス

会場名	収容人数	2016年3月19日(土)		2016年3月20日(日)		2016年3月21日(月)		2016年3月22日(火)		
		午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	
70周年記念講堂	KD	644	特別シンポジウム 科学と産業の凋落と再興：応用物理と未来社会	8.2 プラズマ診断・計測 8.11 業績賞受賞記念講演	8.10 プラズマエレクトロニクス賞授賞式 S.16 宇宙科学・工学とプラズマプロセッシング		S.20 次世代高効率・低コスト結晶シリコン太陽電池	特別シンポジウム『フォノンエンジニアリングの広がり』～ナノスケール熱制御がもたらす、新しい熱伝導・断熱、蓄熱、変換技術の基礎と応用	特別シンポジウム『フォノンエンジニアリングの広がり』～ナノスケール熱制御がもたらす、新しい熱伝導・断熱、蓄熱、変換技術の基礎と応用	
本館	H101	200	S.3 銅酸化物超伝導体発見30周年記念シンポジウム	15.6 IV 族系化合物(SiC)	15.6 IV 族系化合物(SiC)	15.6 IV 族系化合物(SiC)	特別シンポジウム 応用物理分野で活躍する女性達 -第4回 プラズマと応用技術編-	S.22 「cavity-QED, circuit-QED の進展」～様々な系で何をどこまでできるようになったのか?～		
	H103	96	6.2 カーボン系薄膜	6.2 カーボン系薄膜	6.2 カーボン系薄膜	6.4 薄膜新材料	6.4 薄膜新材料		6.4 薄膜新材料	
	H111	112	6.3 酸化物エレクトロニクス	6.3 酸化物エレクトロニクス	6.3 酸化物エレクトロニクス	S.14 機能性酸化物探索の新展開 ~ more oxide, beyond oxide ~	6.3 酸化物エレクトロニクス	6.3 酸化物エレクトロニクス		
	H112	80	15.1 バルク結晶成長	15.1 バルク結晶成長	15.5 IV 族結晶, IV-IV 族混晶	15.5 IV 族結晶, IV-IV 族混晶	15.7 エピタキシーの基礎 15.3 III-V 族エピタキシャル結晶			
	H113	80	6.5 表面物理・真空	6.5 表面物理・真空	15.8 結晶評価, 不純物・結晶欠陥	15.8 結晶評価, 不純物・結晶欠陥	15.2 II-VI 族結晶および多元系結晶	6.6 プローブ顕微鏡	6.6 プローブ顕微鏡	6.6 プローブ顕微鏡
	H116	72	3.16 Optics and Photonics English Session	3.1 光学基礎・光学新領域		3.8 光計測技術・機器	3.8 光計測技術・機器	3.8 光計測技術・機器	15.2 II-VI 族結晶および多元系結晶	15.2 II-VI 族結晶および多元系結晶
	H121	240	15.4 III-V 族窒化物結晶	15.4 III-V 族窒化物結晶	15.4 III-V 族窒化物結晶	15.4 III-V 族窒化物結晶	15.4 III-V 族窒化物結晶	15.4 III-V 族窒化物結晶	15.4 III-V 族窒化物結晶	15.4 III-V 族窒化物結晶
	H135	112		S.23 テラヘルツ・赤外線領域強電磁場による極限非線形現象の光科学と応用展望	3.9 テラヘルツ全般	3.9 テラヘルツ全般	3.2 材料・機器光学	S.12 社会実装を見据えたテラヘルツ新技術の展開	3.9 テラヘルツ全般	
	H137	66		7.1 X線技術		7.5 イオンビーム一般		7.2 電子ビーム応用		
南講義棟	S011	153	S.6 発光イメージングが切り拓く半導体結晶・デバイス評価の明るい未来	13.10 化合物太陽電池	13.10 化合物太陽電池 17.2 グラフェン	17.2 グラフェン	17.2 グラフェン	17.2 グラフェン		
南2号館	S221	173	S.8 日韓ジョイントシンポ：機能性2次元材料の現状と新展開	13.3 絶縁膜技術	13.3 絶縁膜技術	13.10 化合物太陽電池	13.10 化合物太陽電池			
	S222	186	特別シンポジウム 産学協働シンポジウム - 未来創生に向けて -	21.1 合同セッションK ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス	21.1 合同セッションK ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス	21.1 合同セッションK ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス	S.21 金属酸化物薄膜の成膜装置	21.1 合同セッションK ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス	21.1 合同セッションK ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス	
	S223	66	13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション	13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション	13.7 ナノ構造・量子現象	13.7 ナノ構造・量子現象 13.9 光物性・発光デバイス	13.2 探索的材料物性・基礎物性	13.2 探索的材料物性・基礎物性		
	S224	66	13.6 Semiconductor English Session	7.3 微細パターン・微細構造形成技術	7.3 微細パターン・微細構造形成技術	3.5 レーザー装置・材料	3.3 情報フォトニクス・画像工学	3.3 情報フォトニクス・画像工学		
南3号館	S321	54		3.13 半導体光デバイス	3.13 半導体光デバイス	3.14 光制御デバイス・光ファイバー	3.14 光制御デバイス・光ファイバー			
	S322	58		1.5 計測技術・計測標準	1.1 応用物理一般・学際領域	1.6 超音波	1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境	1.3 新技術・複合新領域		
	S323	61				9.5 新機能材料・新物性	9.3 ナノエレクトロニクス	9.3 ナノエレクトロニクス		
南4号館	S421	102			17.3 層状物質	17.1 カーボンナノチューブ, 他のナノカーボン材料	17.1 カーボンナノチューブ, 他のナノカーボン材料	17.3 層状物質		
	S422	72			13.5 デバイス/集積化技術	13.5 デバイス/集積化技術	13.5 デバイス/集積化技術	3.4 生体・医用光学		
	S423	72	13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・配線・MEMS・集積化技術	13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・配線・MEMS・集積化技術	13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・配線・MEMS・集積化技術	13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・配線・MEMS・集積化技術	13.9 光物性・発光デバイス	13.9 光物性・発光デバイス	13.9 光物性・発光デバイス	13.9 光物性・発光デバイス
南6号館	S611	64				CS.1 3.5 レーザー装置・材料と3.14 光制御デバイス・光ファイバーのコードシェアセッション 3.5 レーザー装置・材料	3.15 シリコンフォトニクス			
	S621	109					CS.3 3.11 フォトニック構造・現象, 13.7 ナノ構造・量子現象のコードシェアセッション	3.11 フォトニック構造・現象	3.11 フォトニック構造・現象	
	S622	109	3.12 ナノ領域光科学・近接場光学	3.12 ナノ領域光科学・近接場光学	3.12 ナノ領域光科学・近接場光学	3.12 ナノ領域光科学・近接場光学	3.6 超高速・高強度レーザー	3.6 超高速・高強度レーザー		

日程表 (会場別) 2

東京工業大学 大岡山キャンパス

会場名	収容人数	2016年3月19日(土)		2016年3月20日(日)		2016年3月21日(月)		2016年3月22日(火)								
		午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後							
西館100	W321	102	16.3 シリコン系太陽電池	3.7 レーザープロセス	3.7 レーザープロセス	S.11 液中レーザープロセス技術の展開	3.7 レーザープロセス		16.3 シリコン系太陽電池							
	W323	101	12.6 ナノバイオテクノロジー	12.6 ナノバイオテクノロジー	12.6 ナノバイオテクノロジー	CS.5 9.4 熱電変換, 16.2 エナジーハーベスティングのコードシェアセッション	9.4 熱電変換	9.4 熱電変換								
	W331	102	12.7 医用工学・バイオチップ	12.7 医用工学・バイオチップ	12.7 医用工学・バイオチップ	12.7 医用工学・バイオチップ	12.7 医用工学・バイオチップ	CS.2 3.7, 12.6, 12.7 のコードシェアセッション「レーザー・ナノ・バイオプロセスとセンシングの融合に向けて」	16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス							
	W241	255		8.9 プラズマエレクトロニクス分科内招待講演 10.4 半導体・有機・光・量子スピントロニクス	10.3 GMR・TMR・磁気記録技術	S.17 様々なスピン計測技術を用いたスピントロニクス材料開発の最新動向	10.1 新物質創成 (酸化物・ホイスラー・金属磁性体等)	10.2 スピントルク・スピン流・回路・測定技術	CS.6 10.1, 10.2, 10.3 のコードシェアセッション「新規スピン操作手法および関連現象」							
	W242	108		12.1 作製・構造制御	12.1 作製・構造制御	12.1 作製・構造制御										
	W351	102			12.3 機能材料・萌芽的デバイス	12.3 機能材料・萌芽的デバイス	12.3 機能材料・萌芽的デバイス	12.3 機能材料・萌芽的デバイス	12.3 機能材料・萌芽的デバイス							
西館100	W521	269		S.4 日韓の有機エレクトロニクス研究: 現状と次の飛躍に向けて		12.4 有機 EL・トランジスタ	12.4 有機 EL・トランジスタ	12.4 有機 EL・トランジスタ	12.4 有機 EL・トランジスタ							
	W531	273		12.5 有機太陽電池	12.5 有機太陽電池	12.5 有機太陽電池	12.5 有機太陽電池	S.19 有機薄膜太陽電池の現状と今後の展望	12.5 有機太陽電池							
	W541	269	チュートリアル1: 川田 善正	S.5 化合物薄膜太陽電池の効率化技術の現在と未来	3.10 量子物理・技術	3.10 量子物理・技術	13.8 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術	13.8 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術	13.8 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術							
西館100	W611	108		8.7 プラズマ現象・新応用・融合分野	16.3 シリコン系太陽電池	S.7 理系学生のキャリア設計指針 ~これからの第一歩を決めるために~	8.1 プラズマ生成・制御	8.8 Plasma Electronics English Session	8.3 プラズマ成膜・表面処理							
	W621	142	チュートリアル2: 高木 浩一	8.4 プラズマエッチング	S.9 科学教育コンテストを活用した次世代人材育成	S.13 真空・減圧プロセスにおける気体の流れの解析	8.6 プラズマライファイエンス	8.6 プラズマライファイエンス	8.5 プラズマナノテクノロジー							
	W631	142	チュートリアル4: 平山 秀樹	S.24 IoT アプリケーションと、それを支えるキーテクノロジー	CS.4 6.6 プローブ顕微鏡, 12.2 評価・基礎物性のコードシェアセッション	S.18 計算材料科学の潮流 - 有機分子・バイオエレクトロニクスを中心に -	12.2 評価・基礎物性	12.2 評価・基礎物性	12.2 評価・基礎物性							
	W641	142	チュートリアル3: 高梨 弘毅	S.1 エネルギーマネジメント: 小規模システムの事例に学ぶ再生可能エネルギーの導入ポテンシャル		S.15 誘電体・強誘電体材料評価・解析技術の最先端	6.1 強誘電体薄膜	6.1 強誘電体薄膜	チュートリアル6: 西永 頌							
西館100	W833	78	11.1 基礎物性	9.1 誘電材料・誘電体	9.1 誘電材料・誘電体	11.1 基礎物性	11.4 アナログ応用および関連技術	11.4 アナログ応用および関連技術	2.3 放射線応用・発生装置・新技術							
	W834	61	9.2 ナノワイヤ・ナノ粒子	9.2 ナノワイヤ・ナノ粒子		11.5 接合、回路作製プロセスおよびデジタル応用	11.2 薄膜、厚膜、テープ作製プロセスおよび結晶成長									
	W810 (E1001)	100	2.2 検出器開発	2.2 検出器開発	2.3 放射線応用・発生装置・新技術	11.3 臨界電流、超伝導パワー応用	2.1 放射線物理一般・検出器基礎	2.1 放射線物理一般・検出器基礎								
多目的ホール	W9	287	奨励賞贈呈式	業績賞授賞式		S.10 医学分野におけるRI利用の現状と展望		特別シンポジウム「Internet of Thingsを俯瞰する」- 応用物理から実装技術、アプリ、ビッグデータまで -	チュートリアル5: 柴田 直							
屋内運動場	P1 ~ P23	ポスターセッション	[09:30~11:30]	7 ビーム応用 12.1 作製・構造制御 12.3 機能材料・萌芽的デバイス 12.4 有機 EL・トランジスタ 12.5 有機太陽電池	[13:30~15:30]	10 スピントロニクス・マグネティクス 13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション 13.3 絶縁膜技術 13.5 デバイス/集積化技術	[09:30~11:30]	6.1 強誘電体薄膜 6.5 表面物理・真空 11 超伝導 17 ナノカーボン	[13:30~15:30]	3.1 光学基礎・光学新領域 3.4 生体・医用光学 3.6 超高速・高強度レーザー 3.11 フォトニック構造・現象 3.14 光制御デバイス・光ファイバー 3.16 Optics and Photonics English Session 9.2 ナノワイヤ・ナノ粒子 9.3 ナノエレクトロニクス 13.8 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術 13.9 光物性・発光デバイス	[09:30~11:30]	1.1 応用物理一般・学際領域 1.2 教育 1.3 新技術・複合新領域 1.5 計測技術・計測標準 1.6 超音波 3.9 テラヘルツ全般 6.6 プローブ顕微鏡 16 非晶質・微結晶	[13:30~15:30]	3.12 ナノ領域光学・近接場光学 3.13 半導体光デバイス 6.2 カーボン系薄膜 8.2 プラズマ診断・計測 8.4 プラズマエッチング 8.5 プラズマナノテクノロジー 8.7 プラズマ現象・新応用・融合分野 15.2 II-VI 族結晶および多元系結晶 15.5 IV 族結晶, IV-IV 族混晶 15.6 IV 族系化合物 (SiC) 15.8 結晶評価, 不純物・結晶欠陥	[09:30~11:30]	1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境 3.2 材料・機器光学 3.3 情報フォトニクス・画像工学 6.3 酸化エレクトロニクス 6.4 薄膜新材料 15.4 III-V 族窒化物結晶
			[16:00~18:00]	8.1 プラズマ生成・制御 8.3 プラズマ成膜・表面処理 8.6 プラズマライファイエンス 8.8 Plasma Electronics English Session 9.1 誘電材料・誘電体 9.5 新機能材料・新物性 12.2 評価・基礎物性 21.1 合同セッションK ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス CS.5 9.4 熱電変換, 16.2 エナジーハーベスティングのコードシェアセッション	[16:00~18:00]	12.6 ナノバイオテクノロジー 12.7 医用工学・バイオチップ 13.2 探索的材料物性・基礎物性 13.10 化合物太陽電池 15.1 バルク結晶成長 15.3 III-V 族エピタキシャル結晶	[16:00~18:00]	2 放射線 3.5 レーザー装置・材料 3.7 レーザープロセス 3.8 光計測技術・機器 3.15 シリコンフォトニクス 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・配線・MEMS・集積化技術								

